

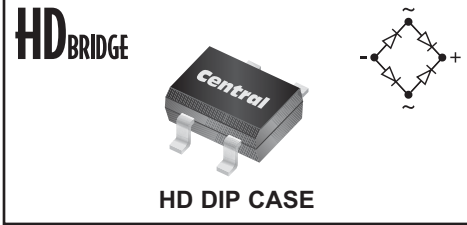
**CBRHDSH2-100**  
**SURFACE MOUNT**  
**HIGH DENSITY**  
**2 AMP SILICON**  
**SCHOTTKY BRIDGE RECTIFIER**



[www.centrasemi.com](http://www.centrasemi.com)

**DESCRIPTION:**

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CBRHDSH2-100 is a full wave bridge rectifier mounted in a durable epoxy surface mount case, utilizing glass passivated chips.



**MARKING CODE: CSH10**

**FEATURES:**

- Low Leakage Current (700nA TYP @  $V_{RRM}$ )
- High 2.0A Current Rating
- Low  $V_F$  Schottky Diodes (840mV MAX @  $I_F=2.0A$ )

• Device is **Halogen Free** by design

<b>MAXIMUM RATINGS:</b> ( $T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)	<b>SYMBOL</b>		<b>UNITS</b>
Peak Repetitive Reverse Voltage	$V_{RRM}$	100	V
DC Blocking Voltage	$V_R$	100	V
RMS Reverse Voltage	$V_{R(RMS)}$	70	V
Average Forward Current ( $T_A=75^\circ\text{C}$ )	$I_O$	2.0	A
Peak Forward Surge Current (8.3ms)	$I_{FSM}$	50	A
Operating Junction Temperature	$T_J$	-50 to +125	$^\circ\text{C}$
Storage Temperature	$T_{stg}$	-50 to +150	$^\circ\text{C}$

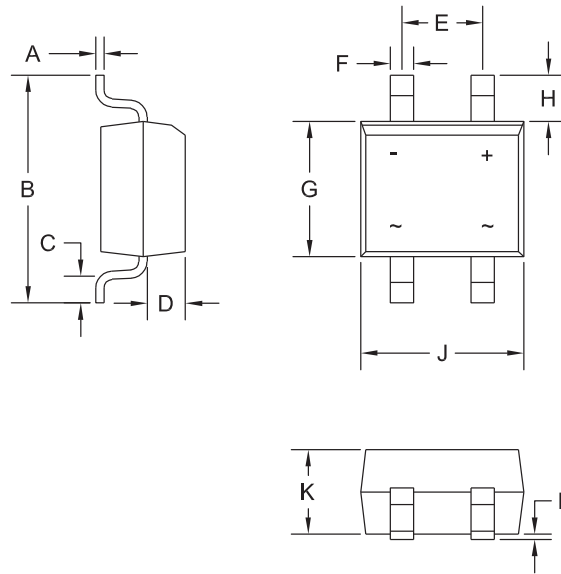
**ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER DIODE:** ( $T_A=25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted)

<b>SYMBOL</b>	<b>TEST CONDITIONS</b>	<b>TYP</b>	<b>MAX</b>	<b>UNITS</b>
$I_R$	$V_R=100V$	0.70	4.0	$\mu\text{A}$
$V_F$	$I_F=500\text{mA}$	610		mV
$V_F$	$I_F=1.0A$	700		mV
$V_F$	$I_F=2.0A$	770	840	mV
$C_J$	$V_R=4.0V, f=1.0\text{MHz}$		250	pF

CBRHDSH2-100  
 SURFACE MOUNT  
 HIGH DENSITY  
 2 AMP SILICON  
 SCHOTTKY BRIDGE RECTIFIER



HD DIP CASE - MECHANICAL OUTLINE



R2

SYMBOL	DIMENSIONS			
	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.006	0.014	0.15	0.35
B	-	0.275	-	7.00
C	0.027	0.043	0.70	1.10
D	0.035	0.051	0.90	1.30
E	0.090	0.106	2.30	2.70
F	0.019	0.031	0.50	0.80
G	0.150	0.165	3.80	4.20
H	0.051	0.067	1.30	1.70
J	0.177	0.193	4.50	4.90
K	0.090	0.106	2.30	2.70
L	0.000	0.008	0.00	0.20

HD DIP (REV: R2)

MARKING CODE: CSH10

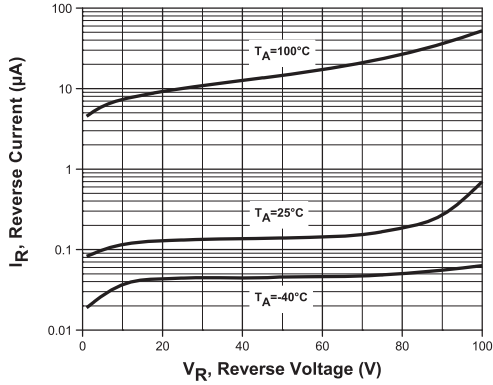
R3 (4-January 2010)

**CBRHDSH2-100**  
**SURFACE MOUNT**  
**HIGH DENSITY**  
**2 AMP SILICON**  
**SCHOTTKY BRIDGE RECTIFIER**

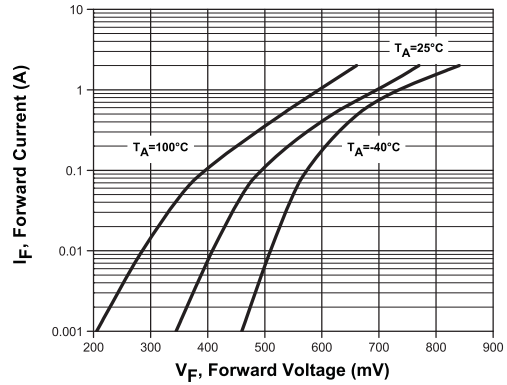


**TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

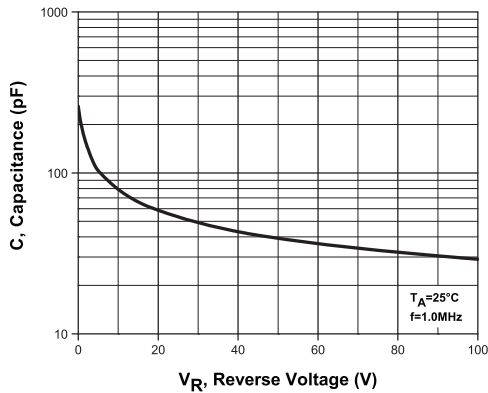
**Typical Per Diode Leakage Current**



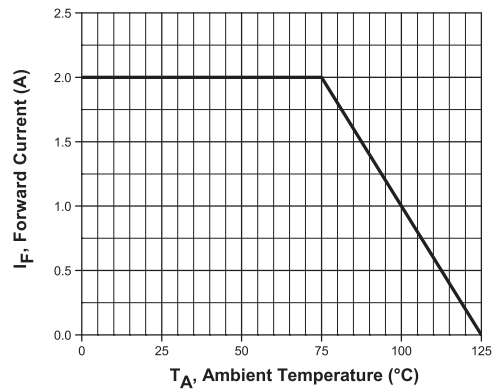
**Typical Per Diode Forward Voltage**



**Typical Per Diode Capacitance**



**Per Diode Current Derating**



R3 (4-January 2010)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.